



AI時代に向けて注目の **SPLEAD**

半導体・エネルギー・量子 基礎研究

2026年度予算選定用
2027年度予算申請用 カタログ

Atomic Layer Deposition Systems **MO-ZERO10**

MOラインの追加が可能特材ガス導入ができる生産開発8inchALD装置です

ALD System (シングルチャンバー)

SPM-560



メタルオーガニック (MO) ガスを導入したMOCVDや飽和表面反応を利用した原子層成膜 (Atomic Layer Deposition) の実験も可能です。2インチ仕様スタンダードALD製後膜装置です。真空チャンバーでウェハを加熱、CVDガスを導入し表面反応を利用したCVD (ALCVD) を行う装置です。次世代半導体開発に。

チャンバー	ステンレスSUS304
基板加熱	プレートヒーターによる加熱(最高温度800℃)PID制御
基板サイズ	2"~4" (仕様によりチャンバー外形が変わります)
原料供給	原料加熱による気化+マスフローコントローラーによる流量調整
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ(ドライポンプ対応可)
成膜	PCによる自動成膜
プリカーサ	最大16系統の増設が可能、特材ガス対応可能
オプション	プラズマALD、高純度オゾナイザー、ロードロック室増設

¥15,000,000

ALD System (ロードロック付)

SPM-591



真空チャンバーでウェハを加熱、CVDガスを導入し表面反応を利用したCVD (ALCVD) を行う装置です。メタルオーガニック (MO) ガスを導入したMOCVDや飽和表面反応を利用した原子層成膜 (Atomic Layer Deposition) の実験も可能です。多種類のガス導入ができる生産開発用ALD装置です。MOラインの追加が可能、次世代半導体開発に。

チャンバー	ステンレスSUS304
基板加熱	プレートヒーターによる加熱(最高温度800℃)PID制御
基板サイズ	2"~4" (仕様によりチャンバー外形が変わります)
原料供給	原料加熱による気化+マスフローコントローラーによる流量調整
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ(ドライポンプ対応可)
成膜	PCによる自動成膜
プリカーサ	最大16系統の増設が可能、特材ガス対応可能
オプション	プラズマALD、高純度オゾナイザー

¥20,000,000

フロントハッチ式EB型電子銃装置 **HV-432S**



6Kw-4cc 7ポケット回転式EBガンによる多種の試料を装着し成膜が可能です。フロントハッチ式で試料交換などの作業が効率よく行えます。またオプションで抵抗加熱式蒸着の取り付けが可能です。

チャンバー	フロントハッチ式 ステンレスSUS304
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
蒸発源	EBガン2CC (4~7ポケット)
最大パワー	3Kw
基板加熱	300℃ (オプション : 900℃可)
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ

¥25,000,000

複合型蒸着装置 (スパッタ・抵抗加熱) **SPE-370**



4元式抵抗加熱蒸着方式で金属や酸化物を加熱して蒸発させ試料表面に堆積させて成膜を行います。予備ポート4個有り、スパッタ、EB蒸発元がつけられます。

チャンバー	ステンレスSUS304
到達圧力	2x10 ⁻⁵ Pa以下
基盤加熱	2"~4" 300℃ (オプション : 900℃可)
蒸発源	ボート式・バスケット式対応可 (シャッター付)
スパッタ源	2"~4" (強磁場マグネット使用)
電源	RF300W+オートチューナー (DC対応可)
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ

¥20,000,000

UHVスパッタリング マグネトロンスパッタ装置



高融点材料や合金など半導体基礎研究に採用されています。

2026年度予算選定用 2027年度予算申請用 カタログ

UHV1元式小型RFスパッタ装置 SP-410SS



実験用薄膜作成用 2"小型スパッタ装置です。
各種材料に応じた電源との組み合わせが可能です。

到達圧力	2x10 ⁻⁵ Pa以下
スパッタ源	2"~4" (強磁場マグネット使用)
基盤加熱	2"~4" (オプション: 900℃可)
電源	RF300W+オートマッチャー
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ
ガス導入	マスフローコントローラー (20sccm)

¥7,000,000

UHV3元式小型RFスパッタ装置 UHV-420S

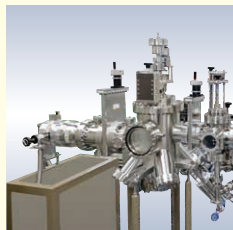


実験用薄膜作成用 2"小型スパッタ装置です。
各種材料に応じた電源との組み合わせが可能です。

到達圧力	2x10 ⁻⁵ Pa以下
スパッタ源	2"~4" (強磁場マグネット使用)
基盤加熱	2"~4" (オプション: 900℃可)
電源	RF300W+オートマッチャー
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ
ガス導入	マスフローコントローラー (20sccm)

¥15,000,000

UHV4元式小型RFスパッタ装置 UHV-421S

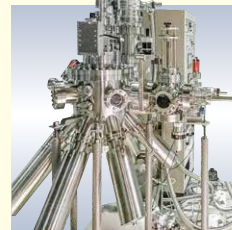


実験用薄膜形成 多元スパッタ装置です。
各種材料に応じた電源、イオンソースなど汎用性の高い装置です。FR、DC両方式のマグネトロンスパッタが可能です。

到達圧力	2x10 ⁻⁵ Pa以下
スパッタ源	2"~4" (強磁場マグネット使用)
基盤加熱	2"~4" (オプション: 900℃可)
電源	RF300W+オートマッチャー
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ
ガス導入	マスフローコントローラー (20sccm)

¥25,000,000

UHV6元式小型RFスパッタ装置 SPP-260S-U



多元スパッタ/抵抗加熱蒸着により金属・酸化物の成膜が可能な装置です。基板回転と独立シャッター制御により多層・多元成膜に対応し、酸素中でも900℃以上の加熱が可能なSiCヒーターとロードロック室により高品質成膜を実現します。予備ポート4基を備え、スパッタやEB源を追加できます。

到達圧力	2x10 ⁻⁵ Pa以下
スパッタ源	2"~4" (強磁場マグネット使用)
基盤加熱	2"~4" (オプション: 900℃可)
電源	RF300W+オートマッチャー
排気系	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ
真空計	フルレンジコールドカソードゲージ
ガス導入	マスフローコントローラー (20sccm)

¥36,000,000

UHVスパッタリング・マグネトロンスパッタ装置 オプション

スパッタ源 2インチから4インチ対応可
逆スパッタ対応可
磁場対応RHEED対応可
DCスパッタ対応可
基板加熱 900℃以上対応可
ロードロック室カセット機構 (2~3枚) 対応可

まずお見積り お気軽にお問合わせください

TEL. 042-379-4655 FAX. 042-379-4656

mail. info3@splead.jp



株式会社 スプリード

SPLEAD



www.splead.jp

〒206-0801 東京都稲城市大丸422-1

環境マネジメントシステム国際規格ISO14001取得



ISO14001:2015 & JIS Q 14001:2015